



2 S D 1 3 4 1 P

シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ
T. V. 水平偏向出力用

暫定規格

绝对最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	7	V
コレクタ電流	I _C	5	A
ピークコレクタ電流	i _{cp}	16	A
コレクタ損失	P _C	50	W
接合部温度	T _j	150	℃
保存周囲温度	T _{stg}	-55~+150	℃

電氣的特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

項 目	条 件	規 格			単位
		MIN	TYP	MAX	
コレクタ ・エミッタ 遮断電流 I_{CBO}	$V_{CB}=800V, I_E=0$			10	μA
コレクタ 維持電圧 V_{CE0} (sus)	$I_C=100mA, I_B=0$	800	—		V
エミッタ遮断電流 I_{EBO}	$V_{EB}=5V$			1	mA
コレクタ・エミッタ 飽和電圧 $V_{CE}(sat)$	$I_C=4A, I_B=0.8A$			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧 $V_{BE}(sat)$	$I_C=4A, I_B=0.8A$			1.5	V
直流電流増幅率 h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	8			
降下時間 t_f 指定回路	$I_C=4A, I_{B1}=0.8A$ $I_{B2}=-1.6A$			0.7	μs

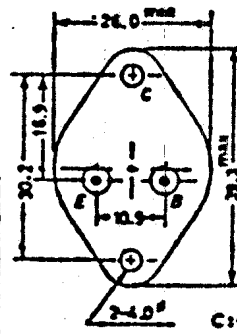
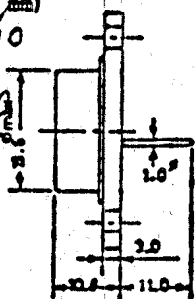
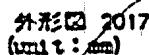
ft

$$V_{CE} = 10V, I_C = 1A$$

3

Mr.

コクタ・ベース降伏電圧 $V_{(BR)CBO}$ $I_C = 5mA, I_E = 0$ 1500
 コクタ・エミッタ $V_{(BR)CEO}$ $I_C = 100mA, R_{BE} = \infty$ 800
 エミッタ・ベース $V_{(BR)EB0}$ $I_E = 200mA, I_C = 0$ $?$



EIAJ. TC-3, TB-3
JEDEC. TO-3

C:Collector
E:Emitter
B:Base

これらの件は、改定などのため発生なく済みます。とあります。